






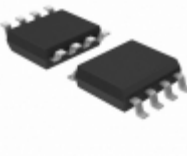
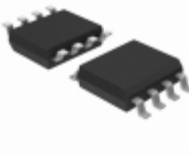

	<h2>SI4124DY-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4124DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 20.5A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4124DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34036 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4124DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 20.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	34036 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 20.5A (Tc) 2.5W (Ta), 5.7W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3540pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4124DY-T1-GE3TR

SI4124DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4124DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4124DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4124DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4124DY VISHAY VISHAY SOP-8</p>	 <p>SI4126-BMR SILICON SI4126-BMR SILICON</p>	 <p>SI4126-BM Energy Micro (Silicon Labs) IC SYNTHESIZER WLAN RF2/IF 28MLP</p>	 <p>SI4124DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 20.5A 8-SOIC</p>
 <p>SI4126-F-BM Energy Micro (Silicon Labs) IC SYNTHESIZER RF2/IF 28MLP</p>	 <p>SI4124DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 20.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4124DY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 20.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4126-F-GM Energy Micro (Silicon Labs) IC WLAN SYNTH (RF2/IF) 28MLP</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ SI4104DY-T1-GE3	➔ SI4104DY-T1-GE3	➔ SI4108DY-T1-GE3	D SI4108DY-T1-GE3	➔ SI4110DY-T1-GE3
➔ SI4110DY-T1-GE3	⚙ SI4112-D-GM	D SI4113-BMR	➔ SI4114DY	➔ SI4114DY-T1-E3
⚙ SI4114DY-T1-E3	➔ SI4114DY-T1-GE3	⚙ SI4114DY-T1-GE3	➔ SI4116DY	➔ SI4116DY-T1-E3
D SI4116DY-T1-E3	⚙ SI4116DY-T1-GE3	➔ SI4116DY-T1-GE3	⚙ SI4122-BTR	➔ SI4122-D-GMR
➔ SI4122DY-T1-E3	➔ SI4122G-BMR	⚙ SI4123-BM	➔ SI4124DY-T1-E3	➔ SI4124DY-T1-E3
➔ SI4124DY-T1-GE3	➔ SI4126-BMR	D SI4126DY-T1-E3	⚙ Si4128BDY	➔ SI4128BDY-T1-GE3
⚙ SI4128BDY-T1-GE3	D SI4128DY	➔ SI4128DY-T1	➔ SI4128DY-T1-E3	➔ SI4128DY-T1-E3
➔ SI4128DY-T1-GE3	⚙ SI4128DY-T1-GE3	➔ SI4133-D-GM	➔ SI4133G-BT	➔ SI4133T-BM
⚙ SI4133T-BMR	➔ SI4133W-BMR	⚙ SI4133X1-BMR	D SI4134DY	➔ SI4134DY-T1
➔ SI4134DY-T1-E3	⚙ SI4134DY-T1-E3	➔ SI4134DY-T1-GE3	⚙ SI4134DY-T1-GE3	➔ SI4134DY/T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited